第八条第二号ハ中「該当するもの」の下に「（有線で結ばれていないものに限る。）」を加え、同号ハに次のように加える。

（四）　レーザー発振器又は発光ダイオードを使用したものであって、これらの出力波長が四〇〇ナノメートル超七〇〇ナノメートル未満であり、かつ、ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの

第八条第五号の三中「、セルラー移動通信」を「、移動通信」に改め、同条第九号中「暗号装置」の下に「又は暗号機能を有する電子組立品、モジュール若しくは集積回路」を加え、「へからル」を「へからヲ」に改め、同号ヘ中「トからル」を「トからヲ」に改め、同号ヌを次のように改める。

ヌ　民生用の携帯用電話機端末又は移動用電話機端末であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

（一）　他の電話機端末その他の装置（無線アクセスネットワーク装置を除く。）に暗号化されたデータを直接送信することができないもの

（二）　無線ネットワーク制御装置、基地局制御装置その他の無線アクセスネットワーク装置を経由して暗号化されたデータを伝達することができないもの

第八条第九号に次のように加える。

ヲ　民生用の携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもののうち、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもの（暗号機能を変更していないものに限る。）

（一）　既に公開又は市販されている暗号標準（無断の複製を防止するためのものであって、公開されていないものを含む。）に準拠したもの

（二）　暗号機能が使用者によって変更できないもの

（三）　使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの

第九条第二号を次のように改める。

二　船舶用の対地速力の測定装置（音波を利用したものに限る。）であって、次のイ又はロのいずれかに該当するもの（水上船に取り付けるように特に設計したもの又は次のハに掲げるものを除く。）

イ　相関速度ログを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

（一）　水底から五〇〇メートルを超える位置で測定を行うことができるように設計したもの

（二）　速力の精度が速力の一パーセント未満のもの

ロ　ドップラー速度ログを用いたものであって、速力の精度が速力の一パーセント未満のもの

ハ　音響測深器であって、水深の測定、水底若しくは水中に存在する物体までの距離の測定又は魚群探知以外の用に供することができないもの

第九条第三号イ中「（ゲルマニウム又はシリコンを用いたものを除く。）」を削り、同号ロを次のように改める。

ロ　イメージ増強管であって、次の（一）又は（二）のいずれかに該当するもの（イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する2の陽極の中心間の距離が五〇〇マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。）

（一）　イメージ増強管であって、次の1から3のすべてに該当するもの

1　四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

2　電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの

一　マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの

二　電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの

3　次のいずれかに該当する光電陰極を有するもの

一　主材料にマルチアルカリを用いたものであって、ルーメン感度が七〇〇マイクロアンペア毎ルーメンを超えるもの

二　主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いたもの

三　主材料にⅢ－Ⅴ族化合物半導体（砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを除く。）を用いたもの（最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。）

（二）　イメージ増強管であって、次の1から3のすべてに該当するもの

1　一、〇五〇ナノメートル超一、八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

2　電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの

一　マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの

二　電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの

3　主材料にⅢ－Ⅴ族化合物半導体（砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含む。）を用いた光電陰極（最大放射感度が一五ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。）又は遷移電子光電陰極を有するもの

第九条第三号ハを次のように改める。

ハ　イメージ増強管又はその部分品であって、次の（一）又は（二）のいずれかに該当するもの（イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する2の陽極の中心間の距離が五〇〇マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。）

（一）　イメージ増強管であって、次の1から3までのすべてに該当するもの

1　四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

2　電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの

一　マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの

二　電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの

3　主材料にマルチアルカリを用いた光電陰極を有するものであって、当該光電陰極のルーメン感度が三五〇マイクロアンペア毎ルーメン超七〇〇マイクロアンペア毎ルーメン以下のもの

（二）　イメージ増強管の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

1　マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの

2　電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの

3　主材料にⅢ－Ⅴ族化合物半導体（砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含む。）を用いた光電陰極（四〇〇ナノメートル超一、〇五〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が一〇ミリアンペア毎ワット以下のもの又は一、〇五〇ナノメートル超一、八〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が一五ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。）又は遷移電子光電陰極